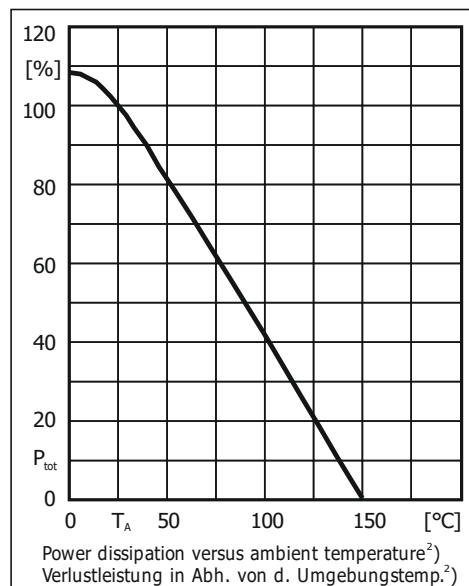


Characteristics
Kennwerte

$T_j = 25^\circ\text{C}$		Min.	Typ.	Max.
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. ¹⁾ - $I_C = 10\text{ mA}$ - $I_B = 1\text{ mA}$ - $I_C = 50\text{ mA}$ - $I_B = 5\text{ mA}$		-	-	0.2 V 0.5 V
Base-Emitter saturation voltage – Basis-Emitter-Sättigungsspannung ¹⁾ - $I_C = 10\text{ mA}$ - $I_B = 1\text{ mA}$ - $I_C = 50\text{ mA}$ - $I_B = 5\text{ mA}$		-	-	1.0 V 1.0 V
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom - $V_{CB} = 120\text{ V}$ E open E open, $T_j = 100^\circ\text{C}$		-	-	50 nA 50 μA
Emitter-Base-cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom - $V_{EB} = 4\text{ V}$ C open		-	-	50 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz - $I_C = 10\text{ mA}$, - $V_{CE} = 10\text{ V}$, $f = 100\text{ MHz}$		100 MHz	-	300 MHz
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität - $V_{CB} = 10\text{ V}$, $I_E = i_e = 0$, $f = 1\text{ MHz}$		-	-	6 pF
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebung		$R_{thA} < 420\text{ K/W}^2)$		



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
 2 Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss